MANUFACTURE OF CONTACTTREACTION TUBES CARRYING CATALYST ON WALL

Patent Number: JP52065190

Publication

date: 1977-05-30

Inventor(s): ANDORUJIEI GORENBIOFUSUKII; SUTANISURAWA BARUFU; ZUJISURAFU YANETSUKII;

ARUFURETO BORANSUKII; WATSURAFU HENNERU; IERUJII JIIERINSUKII; TSUEZARII

WARUZETSU; UOITSUEFU RISOFUSUKII

Applicant(s):

INST NABOZOFU SUTSUKUZUNITSUHI

Requested

Patent: <u>JP52065190</u>

Application

Number: JP19750141039 19751125

Priority Number

IPC'

JP19750141039 19751125

IPC

Classification: B01J23/74; B01J35/10; B01J37/00; C10G13/30; C10G35/06

EC

(s):

Classification: Equivalents:

Abstract

Data supplied from the esp@cenet database - 12

BEST AVAILABLE COPY

許如

(4000円)



昭和50年11月25日

特許庁長官 斎 郎 英 雄 殿



2. 特許請求の範囲に記載された発明の数

3. 発 明 者

住所 ポーラント国・ブラウィ・ボルナ ストリー

氏名 アンドルジェイ ゴレンピオフスキイ

アスキイ 50.11.20

1. 特許出願人 24-110

住所 ポーラント国・プラウィ 3

氏名 インスティテュート ナウォズフ シツシニフ 代表者 ジェルジイ パラノフスキイ

国籍 ポーランド国

喜業で

5. 代 碧 人

住所 東京都悠区芝琴平町13番地 静光応ノ門ビル 電話 504-0721

氏名 弁理士 (6579) 育 木 朗 (外3名)

50 141039

明 細 書

1. 祭明の名称

壁上に触媒を担持せる接触反応管の製法

2. 特許請求の範囲

金属管際面上に電解によって金属の多孔質スポンジ層を生成し、次いで、該スポンジ層に、焼成すると水素存在下に非選元性である金属酸化物に変換する塩を水溶液として含浸せしめ、次いで焼成するとを特徴とする、特に炭化水素の気相リフォーミングおよびメタン化に有用を壁上に触媒を担持せる接触反応管の製法。

3. 発明の詳細な説明

この発明は、新しいタイプの接触反応器の構成 に用いられる接触管の製法に関する。この接触反 応管の壁上には薄い触媒層が密着して形成されて おり、かかる触媒は「壁上担持触媒」と呼ばれ、 壁体と触媒とを併せて「接触管」と呼ばれる。

上述のタイプの反応器は近年知られに至ってお

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 52-65190

43公開日 昭52.(1977) 5.30

②特願昭 10-141037

②出願日 昭如 (1974 // 21

審査請求 未請求

(全5頁)

庁内整理番号 670メ 4A 670メ 4A 67P¥ 46 670メ 4A 6P46 46 670メ 4A

②日本分類 /メリリテロ/ /メリリテロユ /メリリティ/ /メリンティ /よ Cト

17 B11

51 Int. Cl2.

識別 記号

BOIJ 37/00 BOIJ 34/101 BOIJ 23/74 C10G 34/06 C10G 13/30

り、特許文献、とりわけ米国特許第3.271.326号、 第 3,3 5 7,9 1 6号、第 3,4 9 9,7 9 7号、第 3,6 7,2,8 4 7 母およびフランス国券許額 1,4 65,4 4 4号に開示さ☆ れている。かかる新しいタイプの反応器は強力な 熱交換が必要となる気相反応、とりわけ炭化水素 の気相リフォーミングおよびメダン化において非 常に有用である。かかる反応器は既知の常用され る粒状触媒床充填型反応器と比較して特に熱循環 が容易であると質り点で使れている。すなわち、 新しいタイプの反応器における触媒と周囲との間 の伝熱は、熱が反応系に供給されるか反応系から 受取られるかにかかわりなく、触媒を担持せる反。 応管の壁を通してのみ行われる。これに対して、 常用される反応器では反応管整から触媒への伝熱 はガスを鉄体として行われるので、温度低下が着 しく、プロセス上不利である。

さらに、新しいタイプの接触反応器は粒状触媒 充填型既知反応器と比較して圧抵抗が低い利点が ある。

かかる利点にもかかわらず幾上に触媒を担持せ

20

10

15

20

る接触管はとれまで当業界で実用に供されていない。その理由は、高温において壁上に十分な持続性を以って付着し且つ高品質の触数を調製する方法に懸点があったからである。すなわち、気相リフォーミングやメタン化の如き反応では触媒にセラミック支持体を金属管壁上に形成すると、。 温度変化に依る熱膨張率の差に起因してセラミック支持体が金属管壁から脱落する。

前述の解許文献は、壁上担持触鉄を用いた化学 反応について一般に入手できる技術情報の基本を なすものであって、ただ3つの場合について壁上 担持触鉄の調製法を開示するに過ぎない。米国等 許第3,271,326号かよび第3,499,797号ではセラ ミック支持体を用いず完全にメタリックな触跡を 提供している。しかしながら、触鉄に関する一般 的知見から、かかる触鉄では触鉄活性金属物質の 再結晶化に原因して触鉄寿命が短かいと言えよう。 触鉄活性金属物質をセラミック支持体、例えば多 孔質A12Os またはMgOからなる所謂キャリャー上 におくならば上配再結晶化を防止することができ 特続性は増大しよう。

フランス等許額 1.4 6 5.4 1 4号には、予め金属管 鬱を酸洗いしておけば金属管壁と触能視特多孔質 セラミック材料との十分緊密な結合が達成される であろうと記載されている。しかしながら、実験 の結果との手法は有効でないととが判明した。

上述の種々の条件を充足する接触管の調製化を ける難点は、本発明方法に従って、金具管内表面 上に電解によって金属スポンジ層を形成し、次い でとのスポンジ層中へセラミックおよび触供活性 物質を入れるととによって解決できる。

との電解プロセスにおいて、触样をコーティングすべき金属管壁は陰極となる。適当な電解液と 適当な陽極、例えばニッケル陽額を選び且つ陰極 上に析出する金属層を適度な多孔質とする、すな わちスポンジとするような条件下に金属管の金属 メッキを行う。生成するスポンジの構造は時に気 解液の固度に依存するととが判明した。スポンジ 構成材料としてニッケルを用いる場合、固度範囲

15~80℃において最良の結果が得られる。さらに、金属管の全長に亘って均等な厚さにスポンツ層を形成するためには、金属管を、他の管と共に、斜めにまたは鉛度に配置して、電解の間電解被のレベルを衝次上昇せしめるととが有効であるととが判明した。

いっぽう、管全体に電解被を満しておき、電解 液を恒温槽と管との間に循環させながら、アノー ドシールドを連続的または間欠的に上昇せしる とも有効であることが判明した。また、スポン ジ層と管験との結合を良くするためには、スポン ジ層中の金属管禁に近接する部分を金属等 能れた部分より密にしなければならない。金属 ポンジの密度かよび孔隙般は、電流密度ならよび 解液温度のみならず電解液のpH 値に依存するの で、これら3つのパラメーターに依って制御よび ことができる。電流密度10~60A/dcd かよび 電解数pH 2.2~6.8 にかいて最良の結果が得ら れる。

本発明方法の実施において、金属スポンジの生

成様ではあるがこれに所定審蔽を含浸せしめる前に、金属スポンジ生成金属管を800~1,200 での温度で饒成すれば触媒の機械的抵抗力はさら に増大することが判明した。

金属スポンジ中にセラミック物質および触媒活 性物質を入れるには、本発明方法に従って、スポ ンジに適当な塩の水溶液を含度させる。スポンジ に含浸せしめた後スポンジは脱水し焼成する。ス ポンジに含浸させるに際しては、最初、焼成時分 解して酸化物となるが反応器の操作条件下(通常、 水素の存在下)では非遺性である酸化物を生成す るような塩を含養せしめ、次いで、所望反応に対 し触媒作用を示す金属の環元性酸化物を生成する ような塩を含浸させるのが好ましい。還元性金属 酸化物を澄元して触媒活性金属の結晶に変換する ことは反応器の操作期間のできるだけ早い時期に 行われる。本発明方法において所定反応に触媒活 性を示すいかなる金属も用いることもでき、例え ばりフォーミングおよびメタン化では Bu,Tr,Th, Ni.Co.Os.Pt.Fe.Mo.Pd および Agを用いること

20

10

ができる。

電解自体は既知の技法でありまた塩を多孔質体 中へ入れることも種々の化学的操作および触鉄調 製化おいて旧来知られているけれども、これら既 知の 2 操作を組合せて接触管を調製することによ って従来知られていない特性が得られることは注 目に値しよう。すなわち、本発明方法によれば金 爲管嬖と金属スポンジ層との結合力が大きく、ス ポンジ層中にセラミック物質を入れることによっ て寿命が増大し、反応器操作中に起るいかなる大 . きな且つ急激な温度変化にも耐える触媒が得られ る。さらに、電解金属スポンジ中に非選元性金農 を入れることによって、既知触媒にみられるよう な触媒括性物質の再結晶化を防ぐことができる。 また、触媒金属の表面は高い経済的効率を以って **炭化水素の気相リフォーミングを達成するに十分** な活性をもっている。かくして、本発明方法によ れば、新しいタイプの反応器、すなわちその鑒上 に触媒を担持せる反応器であって実用度の高いも のが得られる。

一様に密整した金属スポンツ展を得た。との層は 厚さ0.6 m、孔隙率5.5 m、粗さ係数2.5 0 であった。次いで、管の内面を洗浄し、そして硝酸アルミニウム溶液を数面含裂せしめ、5.00~1000 でで構成した。硝酸ニッケルを用いて同様を操作を2回級返した。得られた既上に担持された触媒を分析したところ、壁上に担持される触媒全体中にためる多孔性 Al₂O₄ の質量は約6.5 であり、触媒の孔隙度は4.1 m、比表面形は1.2 m//9 であった。

実施例2

外径 4 2 m、内径 3 0 mのオーステナイト系クロム・ニッケル鋼製管を鉛度に配置し、そして、 絶終シールド内に収容した直径 6 mのニッケル権をこの鋼管の軸位数に挿入した。管全体を管解液機と結び、実施例1 で用いたものと同一の電解液を液物と管との間を循環せしめた。電解液温度は 8 0 でに一定に保持した。直流電流をカソード上電流密度 10 A / d cdl にてニッケル棒と管両者間に通した。アノード絶録シールドを徐々に上昇して

. . . :

宴旅例1

との例ではメタンを祭相リフォーミングして水 素に富むガスを得るために使用する反応器を説明 する。

オーステナイト系クロム・ニッケル側から外径 42m、内径30mの管を製造し、これを次のよ うに処理して接触反応管とした。各管を鉛直に配 置し、各管の軸上に径6mのニッケル棒を挿入し、 そして全体を次掲組成の電解液中に浅く浸漬した。

NiSo4.7H2O

808/2

10

NH CI

508/4

NaCl

2008/6

ニッケル棒および管両者を電極として 3.5 V 直流 電流を通した。電解液のレベルをニッケル準の溶 値に対応させて漸次上昇させた。カソード上の電 流密度は約20 A/dal であった。電解液温度は約 37でであった。処理した管は水素雰囲気中1050 でで2時間鏡成した。

その結果、管の全長に亘って管の内面に非常に

管上に金្スポンジを限次析出形成した。電解液の rH に電解期間全体を通じて一定値(2,2) に保持した。次いで管を水素雰囲気中1050でで2時間鏡成した。かくして管の全長に亙って管の内面に非常に一核に密射したスポンジ順を得た。 との形は厚さ0.5 mm、孔隙率50%であった。次いで、実施例と同様な方法でセラミック材料をよび活性物質を附着せしめた。この監上に触機を担待せる管は、水薬気を用いるメタンのリフォーミングに非常に優れた触媒性能を示した。

爽施例3

実施例2記載の手法に従って壁上担特触媒を簡製した。ただし、金属スポンジ階の生成条件は次のように変えた。電解液温度15℃、電流密度60A×1㎡、電解液pH6.8。得られた触媒の孔機度は約7c5であり、触媒性能は実施例2とほぼ同様であった。

灾施例4

実施例2 記載の手法に従って外径 4 2 mm、内径 3 0 mm の網管の内面に金属スポンジ層を折出生成

20

15

10

20

させた。電解散型版は50℃に保持し、電流電板は30A/dal、電解散りHは5.9とした。次いで管を1050℃の環光性界断気中で2時間焼成した。係られたスポンシ層は厚さ0.5 m、孔敷度65%であった。このようにして得た管の内面に実施例1と同様な学法でセラミック材料および活性物質を附着せしめた。得られた壁上掛持触なはメタンおよび水蒸気から水素を製造するプロセスに良好な活性を示した。

実施例5

映施例1と同様な手法で得たニッケルスポンジ 付鋼管に硝酸アルミニウム溶液を2度含受し、次 いで1000でおよび500でで鉄成した。冷却 後、硝酸ロジウムの10%溶液を含受し、過剰の 被を除去し、冷却し、800でで1時間離元処理 を行った。100でに冷却した後№2と02の混合物 中で不活性化した。この優上に担持せる触媒を分析したところ、転上に担待される触媒全体中にた める多孔性A1203の質量は約6%であり、触媒の 孔版異は約40%、比表而積は15㎡/9であっ

つつ個解を行う特許請求の範囲記載の方法。

- (2) 電解液を恒晶槽と金属管との間に循環させながら電解を行う特許耐求の範囲配載の方法。
- (3) スポンジ脂形成材料としてニッケルを用い、 電解を 1 5 ~ 2 0 ℃にて行う特許請求の範囲記載 の方法。
- (4) 金属管をカソードとし、該金属管の軸に沿って金属棒を挿入してこれをアノードとし、該金属管 および金属棒を鉛直または斜めに配置して関係級のレベルを断次上昇せしめながら関係を行う、 等許額水の範囲記載の方法。
- (5) スポンジ層のうち金属管と直接密船する額1部分がスポンジ層の喪り部分、すなわち後から生成する部分より大きな密展を有するような条件下に電解を行う特許請求の範囲記載の方法。
- (6) 金属スポンジ層の生成後ではあるが設スポンジ層中に塩を含浸せしめる前に800~1,200 でにおいて結成を行う特許請求の範囲記載の方法。
- (7) 体流密度 10~60 A/dai にて解解を行う特許関求の範囲記載の方法。

た。

突施例 6

実施例」と同様か手法で得た金属スポンジ付銅管を水素界研気中800℃で4時間傍成した。冷却後、実施例1と同様な手法でセラミック材料かよび活性物質を附着せしめた。得られた壁上担持触株は管内面に密着し、孔隙度50%、比表面積約13㎡/9であった。

実施例7

実施例1と同様な手法で得た金属スポンジ付偶管を水素雰囲気中1200℃で1時間焼成した。 冷却後、実施例1と同様な手法でセラミック材料 および活性物質を附着せしめた。得られた触旋は 孔隙穿約45%、比表面積10㎡/タであった。

本務即方法の実施関機を要約すると次のとかり である。

(1) 金属管をカソードとし、該金属管の軸に沿って金属棒を挿入してとれをアノードとし、該金 展管中に電解液を満たして金属棒アノードに装置 せるシールドを連続的または間欠的に上昇せしめ

(8) 電解液の pH 値を 2.2 ~ 6.8 の間に保持しながら電解を行う特許請求の範囲記載の方法。

10

特 許 出 顧 人 インスティテュート ナウェズフ シンシニフ

特許出願代理人

并理士 南 本 即 种理士 两 和 之 种理士 内 田 奉 男 升理士 山 口 昭 之

特朗 昭52-65190(5)

舘 和 之

母 男

口昭之

電話 504-0721

田

住所 東京都港区芝罘平町13街地 静光虎ノ門ビル

弁理士 (7210) 西

弁理士 (7079)内

弁理士 (7107) 山

所

6. 添附密類の目録

1 通 1 通 (2)

委任状及び訳文

各 1 通

7. 前配以外の発明者、特許出國人または代理人

(1) 発明者

ポーラント国、ブラウィ・アル・イェドノシツィ 住所

ストリート 9/16 スタニスラワ パルフ 氏名

ポーラント国・ブラウィ・22 リブツァ ストリート 43/6 ズンスラフ ヤネツキイ 住所

氏名

ポーランド国、ブラウィ、エム・ツェ 住所

スクロドフスキエイ ストリート 6/39 ブルフレト ボランスキイ 氏名

ポーランド国、プラウィ・22 リプツァ ストリート 24/12 ワッラフ ヘンネル 住所

氏名

住所 ポーランド国。ワルシァワ、ペレツァ ストリート 2/1012

イェルジィ ジィエリンスキイ 氏名

ボーランド国、ワルシァワ、エム・4 アル・ニエボトングロシィフィ 64/68 ツェザリイ ワルゼツ スショート 住所

氏名

ボーラント国・ワルシャワ・シュチェンシリウィツカ 住所

ストリート 21/9 氏名 ウォイツェフ リソフスキイ

(2) 特許出額人

な

手続補正費 (自発)

昭和 51 年 2 月 4 日

特許庁長官 片山石 郎 殿

1. 事件の表示

班公

第141039号 昭和 50年 特許顯

2. 発明の名称

壁上に触媒を担持せる接触反応管の製法

3. 補正をする者

特許出願人 事件との関係

名 休、 インスティテュート ナウォズフ シツシニフ

4.代理人

住 所 東京都港区芝琴平町13番地

静光虎ノ門ビル

·氏名 弁理士(6579) 青木

電話(504)0721 泛作剂 印影到 朗

(外 3 名)

(8) 代理人

住所 问

氏名

氏名

住所

氏名

明細書の「発明の詳細な説明」の欄

6. 補正の内容

5. 補正の対象

(1) 明細書第6頁第19行、「Tr, Th」を 『Ir, Rh』に補正する。

(2) 明細書第13頁第5行、「20」を『80』 に補正する。

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.